CERAMIC HEATER

Patent Number:

JP6176855

Publication date: .

1994-06-24

Inventor(s):

NOBORI KAZUHIRO; others: 01

Applicant(s):

NGK INSULATORS LTD

Requested Patent:

☐ JP6176855

Application Number: JP19920321921 19921201.

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05B3/14; H01L21/22; H01L21/324

EC Classification:

Equivalents:

JP2644660B2

Abstract

PURPOSE:To provide a ceramic heater equiped with a temp. measuring mecha nism which can measure the temp. of the heater accurately and stably.

CONSTITUTION: A resistance heat emitting element 2 consisting of a high melting point metal is embedded in a ceramic base body 1. A threaded area 3 is furnished on the surface of base body 1 other than the wafer heating surface 1a on which a wafer is placed, and a thermocouple 6 for temp. measuring is fixed to this threaded area 3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-176855

(43)公開日 平成6年(1994)6月24日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 3/14 H01L 21/22 B 7913-3K

N 9278-4M

21/324

H 8617-4M

審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-321921

(71)出願人 000004064

日本碍子株式会社

(22)出願日

平成 4年(1992)12月 1日

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72)発明者 ▲昇▼ 和宏

愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田字北宿二ノ

切66番地の1

(72)発明者 牛越 隆介

岐阜県多治見市元町四丁目8番地8

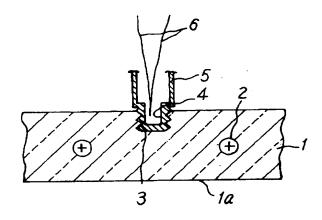
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

(54)【発明の名称】 セラミックスヒーター

(57)【要約】

【目的】 セラミックスヒーターの温度を正確かつ安定 に測定することのできる温度測定構造を有するセラミッ クスヒーターを提供する。

【構成】 セラミックス基体1中に髙融点金属からなる 抵抗発熱体2を埋設してなるセラミックスヒーターにお いて、前記セラミックス基体1のウェハーを載置するウ ェハー加熱面1a以外の面にネジ部3を設け、このネジ 部3に温度測定用の熱電対6を固定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックス基体中に高融点金属からな る抵抗発熱体を埋設してなるセラミックスヒーターにお いて、前記セラミックス基体のウェハーを載置するウェ ハー加熱面以外の面にネジ部を設け、とのネジ部に測温 体の先端を固定したことを特徴とするセラミックスヒー ター。

【請求項2】 前記測温体の先端の固定を、前記セラミ ックス基体に設けた雌ネジ部に、熱電対を保護するシー スの先端部に設けた雄ネジ部を螺合させて行う請求項1 記載のセラミックスヒーター。

【請求項3】 前記測温体の先端の固定を、前記セラミ ックス基体に設けた雌ネジ部に、熱電対自体の先端部に 設けた雄ネジ部を螺合させて行う請求項1記載のセラミ ックスヒーター。

【請求項4】 前記測温体の先端の固定を、前記セラミ ックス基体に埋設した塊状埋設体に設けた雌ネジ部に螺 合させて行う請求項1記載のセラミックスヒーター。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、緻密なセラミックス基 体中に高融点金属からなる抵抗発熱体を埋設してなる好 ましくは半導体ウェハー加熱用のセラミックスヒーター に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体製造装置等における熱源と しては、いわゆるステンレスヒーターや間接加熱方式の ものが一般的であった。しかし、これらの熱源を用いる と、ハロゲン系腐食ガスの作用によってパーティクルが 発生したり、熱効率が悪いといった問題があった。こう した問題を解決するため、本発明者らは、緻密質セラミ ックスからなる円盤状の基体の内部に、髙融点金属から なる抵抗発熱体を埋設したセラミックスヒーターを提案 した。

【0003】上述したセラミックスヒーターにおいて は、加熱時の温度制御のためセラミックスヒーターの温 度を測定する必要があり、そのためセラミックスヒータ ーに温度測定用の熱電対を設けていた。図6は従来の熱 電対の取り付け方法の一例を示す図である。図6におい て、21は窒化珪素等のセラミックスよりなるセラミッ クス基体、22はW、Mo等の髙融点金属よりなる抵抗 発熱体、23はウェハー加熱面21a以外の面に設けた 熱電対の取り付け穴、24は熱電対、25は熱電対を保 護するためのシース、26はシース25を取り付け穴2 3に固定するための接着用ガラスである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図6に 示す従来の熱電対取り付け方法では、セラミックス基体 21とシース25とは接着用ガラス26を介して接着・ 固定されており、接着用ガラス26の安定性、密着性の 50 の28.6倍が断面の接触距離となる。従って、深さ 1

不良や熱接触抵抗の問題により、セラミックスヒーター の温度を正確かつ安定に測定することができず、セラミ ックスヒーターの安定した温度制御をすることができな い問題があった。また、接着用ガラス26の代わりに、 カーボン接着剤や無機接着剤等の他の材料を使用すると ともできるが、やはり同様の問題があった。

【0005】本発明の目的は上述した課題を解消して、 セラミックスヒーターの温度を正確かつ安定に測定する ことのできる温度測定構造を有するセラミックスヒータ ーを提供しようとするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明のセラミックスヒ ーターは、セラミックス基体中に高融点金属からなる抵 抗発熱体を埋設してなるセラミックスヒーターにおい て、前記セラミックス基体のウェハーを載置するウェハ ー加熱面以外の面にネジ部を設け、このネジ部に温度測 定用の熱電対を固定したことを特徴とするものである。 [0007]

【作用】上述した構成において、熱電対をセラミックス 20 基体にネジ止めして固定しているため、熱電対とセラミ ックス基体との直接接触する面積が従来の例と比べて大 きくなり、その結果セラミックスヒーター自体の温度を 正確に測定することができる。また、熱電対とセラミッ クス基体との固定をネジ止めにより行っているため、温 度測定時の接触状態が変化しにくく、セラミックスヒー ターの温度を安定して測定することができる。

[0008]

【実施例】図1は本発明のセラミックスヒーターの一例 の構成を示す図である。図1に示す実施例において、1 は窒化珪素等のセラミックスよりなる円盤状のセラミッ クス基体、2はセラミックス基体1中に埋設したW、M o等の髙融点金属よりなる抵抗発熱体である。この抵抗 発熱体2は好ましくは螺旋状に巻回されるとともに、円 盤状のセラミックス基体2を平面的にみると、抵抗発熱 体2は渦巻形をなすように配置されている。また、セラ ミックス基体1のウェハー加熱面1a以外の面、図1に 示す例ではセラミックス基体1のウェハー加熱面1aと 反対側の面に、深さ1の雌ネジ部3を設けている。そし て、先端部にこの雌ネジ部3と螺合する雄ネジ部4を有 40 するシース5を準備し、シース5の内部に熱電対6を固 定した状態で、シース5の雄ネジ部4とセラミックス基 体1のネジ部3とを螺合して、熱電対6を内部に固定し たシース5をセラミックス基体1に固定している。 【0009】ととで、図2に示すネジの公式に従って、 ネジ部を設けたことによる接触面積の増大について考え てみると、M3のネジで図1に示す深さ1が10mmの 場合を考えてみると、ピッチがP=0. 35でネジ山は 28.6個となる。ネジ山一個の接触面積を断面の距離 として求めると2×(H1/cos30°)となり、こ

= 10mmに対する断面の接触距離しはL=2×(0. $54 \times 0.35 / 0.87) \times 28.6 = 12.5 mm$ となり、接触面積は約1.25倍となる。また、M5の ネジで同様の条件でピッチがP=0.5のときを考える と、断面の接触面積はL=2×(0.54×0.5/c os30°)×20=12.5mmとなり、同様に接触 面積が約1.25倍となる。

【0010】図3は本発明のセラミックスヒーターの他 の例の構成を示す図である。図3に示す例において、図 1に示す例と同一の部材には同一の符号を付し、その説 10 明を省略する。図3に示す例において、図1に示す例と 異なるのは、熱電対自体を直接セラミックス基体にネジ 止め固定した点である。 すなわち、熱電対6を、一対の リード線11a、11bと金属製の先端部12とから構 成し、リード線11a、11bを先端部12に溶接する とともに、先端部12の外周に雄ネジ部4を形成し、セ ラミックス基体 1 に形成した雌ネジ部 3 と螺合して固定 している。先端部12の材質としては、髙温でも使用で きる点からPtを使用することが好ましい。図3に示す 例では、図1に示す例と比較して、先端部12がバルク 形状であり熱容量が大であるため、、温度の変動が少な くできさらに安定してセラミックスヒーターの温度を測 定することができる。

【0011】図4は本発明のセラミックスヒーターのさ らに他の例の構成を示す図である。図4に示す例におい ては、セラミックス基体31に、抵抗発熱体32を埋設 するとともに、金属またはセラミックスからなる塊状埋 設体34を一体となして、この塊状埋設体34に雌ネジ 部36を設け、熱電対先端35をネジ込み固定してい る。また、熱電対先端35より、リード線33a,33 30 bを取り出している。図4に示す構造のメリットは、塊 状埋設体34を加工しやすい材質(例えばW、Mo、S iC) にすることによって、安価なセラミックスヒータ ーを提供できることである。

【0012】図5は本発明のセラミックスヒーターのさ らに他の例の構成を示す図である。図5に示す例におい ては、熱電対先端44とセラミックス基材41との間に インサート金具47を入れ、外周の雄ネジ部45にてセ ラミックス基体41と結合するとともに、内周の雌ネジ 部46にて熱電対先端44と結合している。また、熱電 40 3 雌ネジ部 対先端44より、リード線43a,43bを取り出して いる。図5に示す構造のメリットは、セラミックスから なる基体41に小さな雌ネジの加工は困難であるため

に、一回り大きなネジとすることが可能であり、安価な セラミックスヒーターを提供できることである。

【0013】本発明は上述した実施例にのみ限定される ものではなく、幾多の変形、変更が可能である。例え ば、上述した実施例では、ネジ部をセラミックス基体1 のウェハー加熱面1 a の反対側に設けたが、この位置は ウェハー加熱面la以外の面であればどこでも良く、例 えば側面にネジ部を設けても同様の効果を得ることがで きることは明かである。また、ネジ部の径および深さも 上述した実施例に限定されるものではなく、セラミック ス基体の大きさ等に応じて適宜選べば良いことはいうま でもない。

[0014]

【発明の効果】以上の説明から明かなように、本発明に よれば、熱電対をセラミックス基体にネジ止めして固定 しているため、熱電対とセラミックス基体との直接接触 する面積が従来の例と比べて大きくなり、その結果セラ ミックスヒーター自体の温度を正確に測定することができ きるとともに、熱電対とセラミックス基体との固定をネ ジ止めにより行っているため、温度測定時の接触状態が 変化しにくく、セラミックスヒーターの温度を安定して 測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のセラミックスヒーターの一例の構成を 示す図である。

【図2】本発明のネジ部により接触面積が増大する例を 説明するための図である。

【図3】本発明のセラミックスヒーターの他の例の構成 を示す図である。

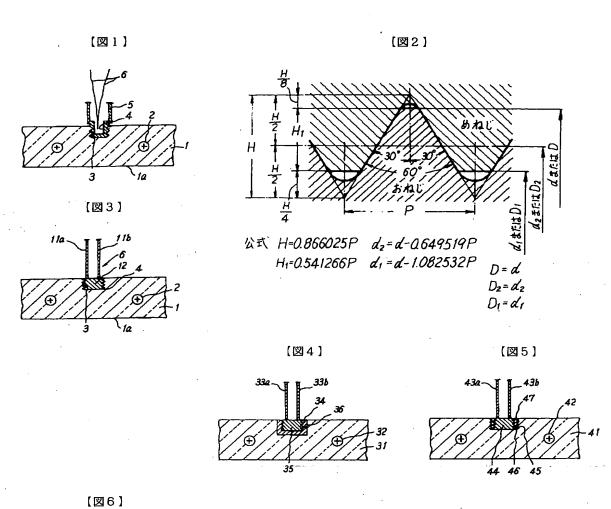
【図4】本発明のセラミックスヒーターのさらに他の例 の構成を示す図である。

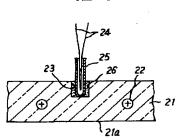
【図5】本発明のセラミックスヒーターのさらに他の例 の構成を示す図である。

【図6】従来のセラミックスヒーターの一例の構成を示 す図である。

【符号の説明】

- 1 セラミックス基体
- 1a ウェハー加熱面
- 2 抵抗発熱体
- - 4 雄ネジ部
 - 5 シース
 - 6 熱電対





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.